

MOSAID Technologies

65nm 공정 기술에 대한 메모리 컨트롤러 및 PLL 제품 출시

첨단 파운더리의 65nm 공정에 고성능 DDR SDRAM 컨트롤러 및 인터페이스 IP 솔루션인 MOSAID Memorize™와 뛰어난 유연성의 Fractional-N PLL 제품군인 MOSAID Maestro™를 사용하여 설계 시간과 전력 소모 및 소형 지오메트리에 대한 제품 리스크를 줄일 수 있다.

글 | 이공홍 기자(leekh@semiconnet.co.kr)

반도체 IP공급업체인 모사이드 테크놀로지스(www.mosaid.com)는 업계 최초로 첨단 65nm 공정에 대한 DDR SDRAM 컨트롤러 및 인터페이스 IP 및 Fractional PLL IP를 제공한다고 발표했다. 고성능 DDR SDRAM 컨트롤러 및 인터페이스 IP 솔루션인 MOSAID Memorize™와 뛰어난 유연성의 Fractional-N PLL 제품군인 MOSAID Maestro™는 현재 첨단 파운더리의 65nm 공정 지오메트리에서 이용할 수 있다.

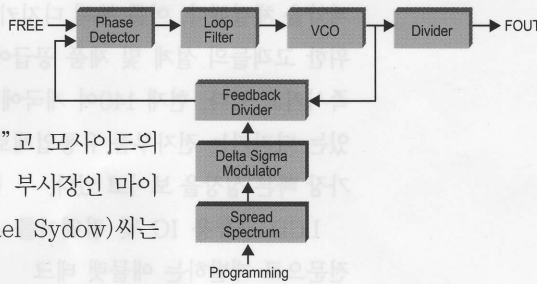
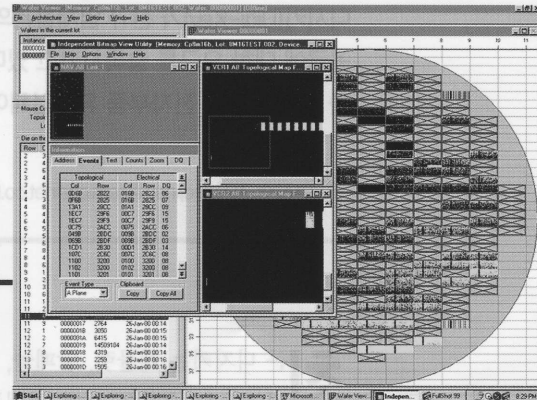
SoC 업계는 보다 향상된 기능 통합과 최종 제품의 소형화, 전반적인 전력 소모를 낮추기 위해 차세대 전자 디바이스의 65nm 공정 노드 채택을 서두르고 있다. 65nm 기술로의 전환은 뛰어난 품질과 완벽한 테스트를 거친 반도체 IP 솔루션의 수요를 증가시키고 있는데, 이들 솔루션은 설계 시간과 소형 지오메트리에 대한 제품 리스크를 줄여 줄 수 있다.

“가전 제품, 특히 휴대용 디바이스를 설계하기 위해 SOC 벤더들은 성능 향상과 관련된 칩 오버헤드를 줄여주는 65nm 공정에 대한 IP를 필요로 하고 있다. 모사이드의 65nm 메모리 컨트롤러와 PLL 솔루션은

성능, 전력, 리스크와 관련된 모든 디자인 문제점들을 해결해 줄 수 있다.”고 모사이드의 반도체 IP 마케팅 부사장인 마이클 시도우(Michael Sydow)씨는 말했다.

MOSAID Memorize™는 고성능 DDR SDRAM 메모리 컨트롤러 IP이다. Memorize™는 최고 1066Mb/s의 DDR2 데이터 속도와 533MHz의 DDR3클럭 주파수를 제공한다. 또한 애플리케이션 전용 SSTL I/O 라이브러리로 버퍼, 필터, 파워, 기본 셀을 갖추고 있다. 마스터 및 슬레이브 DLL 라이브러리는 센터 블록의 하드 IP로 제공하고, 대부분의 메모리 컨트롤러는 소프트 IP로 제공하므로 고객들은 컨트롤러 로직을 전체 칩 아키텍처에 통합할 수 있다.

모사이드의 Fractional-N PLL Maestro™은 완전 통합형 프로그래머블 솔루션으로 저전력, 고성능 및 델타-시그마 Fractional-N PLL를 제공한다. 따라서 시스템 클럭이 3.2GHz 이상의 데이터 속도로 동작하는 배터리 구동 애플리케이션의 제품 라인에 최적화되어 있다. **SN**



마이클 시도우

MOSAID에 대하여

1975년에 설립된 모사이드 테크놀로지스는 IP 개발 및 라이선스, 메모리 테스트 및 분석 시스템을 공급하는 반도체 IP 전문 업체이다. 컴퓨터의 주요 메모리인 DRAM 제품에 사용되는 핵심적인 회로 기술을 개발하여 1980년대에는 엔지니어링 애플리케이션 전용 메모리 테스트 시스템을 상용화했다. 캐나다 오타와, 오타리오 및 미국 산타클라라, 영국, 일본 도쿄 등에 사무소를 두고 있다.